05

Магнитоэлектрический эффект в многослойных структурах арсенид галлия никель—олово—никель

© Д.А. Филиппов,¹ А.А. Тихонов,¹ В.М. Лалетин,² Т.О. Фирсова,¹ И.Н. Маничева¹

¹ Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,

173003 Великий Новгород, Россия

² Институт технической акустики НАН Беларуси,

210023 Витебск, Беларусь

e-mail: Dmitry.Filippov@novsu.ru

(Поступило в Редакцию 19 июня 2017 г.)

Представлены результаты экспериментального исследования магнитоэлектрического эффекта в многослойных структурах никель—олово—никель, полученных гальваническим осаждением на подложку из арсенида галлия. Описана технология изготовления структур и представлена частотная зависимость эффекта. Показано, что использование олова в качестве промежуточного слоя уменьшает механические напряжения, возникающие вследствие несоразмерности фаз на границе никель—арсенид галлия, что позволяет получать качественные структуры с толщиной никелевого слоя порядка 70 µm. Полученные структуры обладают хорошей адгезией между слоями и имеют высокую добротность.

DOI: 10.21883/JTF.2018.02.45407.2391

Введение

Слоистые композиционные магнитострикционно-пьезоэлектрические материалы привлекают к себе внимание тем, что величина магнитоэлектрического (МЭ) эффекта в них значительно больше, чем в объемных композитах [1]. По сравнению с объемными композитами они обладают малыми токами утечки благодаря тому, что магнитострикционная фаза с более высокой проводимостью изолируется пьезоэлектрической фазой с высоким удельным сопротивлением. При этом в качестве магнитострикционной фазы можно использовать материалы с высокой проводимостью, обладающими большим коэффициентом магнитострикции. Большинство слоистых магнитострикционно-пьезоэлектрических структур получено методом склеивания фаз. Однако использование клея делает процесс крайне нетехнологичным, кроме того, уменьшается величина эффекта и ухудшается добротность структуры [2]. Большим недостатком клеевых слоистых структур является плохая механическая прочность, расслоение образцов по границам фаз. Это существенно ограничивает практическое применение таких структур.

При выборе материалов для изготовления структур в качестве магнитострикционной фазы обычно выбирают материал с бо́льшим коэффициентом магнитострикции λ , такие как Ni, Co, FeCo, FeGa, аморфные и редкоземельные сплавы, а в качестве пьезоэлектрической фазы старались использовать материалы с бо́льшим пьезоэлектрическим модулем d (керамика цирконататитаната свинца, кристаллы магниониобата—титаната свинца, кристаллы магниониобата—титаната бария и т.д.) [3,4]. Однако, как показывают расчеты [5], величина МЭ эффекта прямо пропорциональна пьезомодулю и обратно пропорциональна диэлектрической про-

ницаемости пьезоэлектрика. Хотя величина пьезомодуля у GaAs почти в 40 раз меньше, чем у ЦТС (GaAs d = -2.69 pKl/m, ЦТС d = 100 pKl/m), его диэлектрическая проницаемость в 135 раз меньше, чем у ЦТС (GaAs $\varepsilon = 12.9$, ЦТС $\varepsilon = 1750$). Это приводит к тому, что при прочих равных условиях следует ожидать, что величина МЭ эффекта в структурах на основе GaAs будет в 3.5 раза больше, чем в структурах на основе ЦТС. Кроме того, использование арсенида галлия в качестве пьезоэлектрика исключает такую операцию, как предварительная поляризация, которая необходима, если в качестве пьезоэлектрика выбирается пьезокерамика ЦТС.

Впервые МЭ эффект в структуре на основе арсенида галлия исследовался в работе [6]. Авторы ушли от клеевых структур и магнитострикционная фаза (Ni) наносилась на подложку из арсенида галлия методом напыления. Это обеспечивало хороший механический контакт между фазами, но не позволяло получить большое значение эффекта. Как показано в работе [7], максимальное значение эффекта достигается при условии выполнения равенства ${}^{p}t\sqrt{{}^{p}Y} = {}^{m}t\sqrt{{}^{m}Y}$, где ${}^{p}Y, {}^{m}Y$ модули Юнга пьезоэлектрика и магнетика, ^{*p*}t, ^{*m*}t — соответственно их толщины. Модули Юнга пьезоэлектрика и магнетика, как правило, отличаются не более чем в два раза, поэтому максимальное значение эффекта получается при примерно одинаковых толщинах магнетика и пьезоэлектрика. Использование метода электролитического осаждения позволяет получить магнитострикционные слои, толщина которых соизмерима с толщиной пьезоэлектрической подложки. Однако при получении толстых слоев возникает проблема адгезии. В работе [8] с целью улучшения адгезии перед электролитическим осаждением на подложку предварительно напылением наносились подслои. Как показали результаты многочисленных опытов, для электролитического осаждения никеля на подложку из арсенида галлия лучше всего использовать подслои состава Au-Ge-Ni. Толщина каждого подслоя составляла порядка 0.15 µm. Полученные структуры имели хорошую адгезию, в них наблюдался МЭ эффект, величина которого была соизмерима с величиной эффекта в лучших клеевых образцах на основе ЦТС, но здесь возникла причина остаточных напряжений на границе раздела. Постоянная решетки GaAs равна 0.5633 nm, а у Ni она равна 0.3524 nm. Это приводит к тому, что при росте толстых слоев в структуре возникают большие механические напряжения. Это существенно снижает механическую прочность образца и даже при небольших механических воздействиях образец разрушается. В настоящей работе с целью уменьшить механические напряжения предлагается вводить буферный слой олова и создавать многослойную структуру никель-олово-никель.

Технология изготовления структур

Исходные образцы вырезались из пластин арсенида галлия с ориентацией поверхности (100) толщиной в форме параллелепипеда с размерами $14 \times 4 \times 0.4$ mm, длинная сторона которых совпадала с направлением (110) кристалла. С целью улучшения адгезии на образцы предварительно напылялись подслои Au-Ge-Ni. Перед нанесением гальванических покрытий все образцы вначале контактировали с помощью никелевой проволоки диаметром 0.2 mm. Затем образцы обезжиривали раствором лабомида 203. Для этого использовали раствор с концентрацией лабомида 203 от 30 до 40 g/l, раствор подогревали до 70–80°C, а время обезжиривания составляло 10–20 min. После обезжиривания образцы промывали в горячей воде с температурой 60–80°C в течение 1 min.

При электролитическом осаждении никеля возникают высокие внутренние напряжения, вследствие чего не удается получить толстые (более $50\,\mu$ m) слои. С целью повышения пластичности покрытий на основе никеля было решено ввести в такие покрытия прослойки из тонких оловянных слоев. Для нанесения гальванических покрытий использовались электролиты, представленные в таблице.

Для всех электролитов применялся толчок тока, т.е. в начале электролиза катодную плотность тока (кратковременно до 1 min) повышали в 2 раза по сравнению с основной рабочей катодной плотностью тока.

При получении многослойной структуры поочередно использовали электролитическое осаждение в сернокислом электролите никелирования № 1, при катодной плотности тока 1 A/dm^2 и температуре электролита $55-65^{\circ}$ С, а затем электроосаждение в электролите лужения № 2 при комнатной температуре и катодной плотности тока 2 A/dm^2 . В результате получили многослойную структуру, состоящую из следующих слоев: оловян-

Компоненты электролита, g/l	Электролит № 1	Электролит № 2
Никель сернокислый семиводный	250	_
Никель хлористый шестиводный	50	_
Олово сернокислое	—	60
Борная кислота	25	—
Серная кислота	_	105
Препарат ОС-20	—	4.5

Составы электролитов, использованные для создания структур

ный — 8μ m, никелевый — 12μ m, оловянный — 9.6μ m, никелевый — 12μ m, оловянный — 38.4μ m, никелевый — 6μ m, оловянный — 8μ m, никелевый — 12μ m, оловянный — 7.2μ m, никелевый — 12μ m, оловянный — 9.6μ m, никелевый — 12.6μ m, оловянный — 9.6μ m. Таким образом, получили сэндвич структуру, состоящую из шести слоев никеля, общей толщиной 66.6μ m и семи слоев олова, общей толщиной 90.4μ m. Общая толщина многослойной структуры составила 157μ m. Покрытие на арсениде галлия получилось ровное, матовое и без видимых дефектов.

Магнитоэлектрический эффект

Магнитоэлектрический эффект в структуре изучался путем измерения напряжения на образце при помещении его в постоянное (подмагничивающее) и переменное магнитные поля. Вначале исследовалась полевая зависимость низкочастотного МЭ сигнала. При постоянном значении напряженности переменного магнитного поля 1 Ое измерялась зависимость МЭ коэффициента от напряженности подмагничивающего поля. Затем при напряженности поля подмагничивания, соответствующего максимуму эффекта, исследовалась частотная зависимость магнитоэлектрического коэффициента в области электромеханического резонанса. Исследовался продольный эффект, т.е. когда постоянное и переменное магнитные поля были направлены вдоль длинной стороны образца. Особенности МЭ эффекта, когда в качестве пьезоэлектрика используется арсенид галлия, заключаются в том, что отличными от нуля компонентами пьезоэлектрического тензора являются $d_{14} = d_{25} = d_{36}$, и поэтому электрическое напряжение, индуцируемое на обкладках образца, возникает в результате деформаций сдвига, а не деформаций растяжение-сжатие, как в ЦТС. В нашем случае переменное магнитное поле, направленное вдоль длинной стороны образца (ось X) индуцирует в магнитной компоненте деформации растяжениясжатия, тензор которых в системе координат, связанных



Рис. 1. Частотная зависимость МЭ коэффициента по напряжению в области электромеханического резонанса.



Рис. 2. Частотная зависимость МЭ коэффициента по напряжению вблизи пика резонанса.

с образцом, обозначим через S_{xx} . Эти деформации передаются в пьезоэлектрик, длинная сторона которого вырезана в направлении (110), и поэтому в системе координат, связанной с кристаллом (x_1 , x_2 , x_3), тензор деформаций будет иметь уже другие компоненты. Используя стандартные преобразования тензоров

$$S_{i'j'} = \beta_{i'k}\beta_{j'i}S_{kl},\tag{1}$$

несложно показать, что в данном случае отличной от нуля будет компонента тензора деформаций $S_6 = \beta_{x_1x}\beta_{x_2x}S_{xx}$, которая и приведет к индуцированию электрического поля. Здесь $\beta_{i'k}$ — матрица косинусов между кристаллографической системой координат и системой координат, связанной с кристаллом.

На рис. 1 приведены результаты экспериментальных измерений частотной зависимости МЭ коэффициента по напряжению. Как видно из рисунка, частотная зависимость имеет резкий резонансный характер. Значение МЭ коэффициента по напряжению значительно ниже, чем в чистой структуре никель-арсенид галлия [8], что объясняется наличием пассивного буферного слоя олова. Однако данная структура имеет очень высокую добротность. На рис. 2 представлена частотная зависимость эффекта в области резонанса. Как следует из рисунка, добротность системы Q = 800, что гораздо лучше добротности образцов, полученных методом склеивания, и сопоставима с добротностью объемных композитов [9].

Заключение

Таким образом, использование промежуточного слоя олова при электролитическом осаждении никеля на арсенид-галлиевую подложку позволяет получить структуры с толщиной никелевого слоя до 70 мкм. Данные структуры имеют хорошую адгезию между слоями, обладают хорошей механической прочностью, имеют высокую добротность и являются перспективными для создания приборов на основе магнитоэлектрического эффекта.

Работа выполнена при поддержке гранта совместного конкурса РФФИ-БРФФИ: Российский проект № 16-52-00184 и Белорусский проект № Ф16Р-130.

Список литературы

- Srinivasan G. // Annu. Rev. Mater. Res. 2010. Vol. 40. P. 153–178.
- [2] Filippov D.A., Galichyan T.A., Laletin V.M. // Appl. Phys. A. 2014. Vol. 116. P. 2167–2171.
- [3] *Vopson M.* // Critical Reviews in Solid State and Materials Science. 2014. P. 1–28.
- [4] Nan C.-W., Bichurin M.I., Dong S., Viehland D., Srinivasan G. // J. Appl. Phys. 2008. Vol. 103. P. 031101.
- [5] Filippov D.A., Laletin V.M., Galichyan T.A. // Appl. Phys. A. 2014. Vol. 115. P. 1087–1091.
- [6] Лалетин В.М., Стогний А.И., Новицкий Н.Н., Поддубная Н.Н. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. Вып. 21. С. 71–77.
- [7] Филиппов Д.А., Лалетин В.М., Galichyan Т.А.// ФТТ. 2013. Т. 55. Вып. 9. С. 1728–1733.
- [8] Филиппов Д.А., Фирсова Т.О., Лалетин В.М., Поддубная Н.Н. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. Вып. 6. С. 72–77.
- [9] Филиппов Д.А., Лалетин В.М., Srinivasan G. // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 1. С. 47–51.